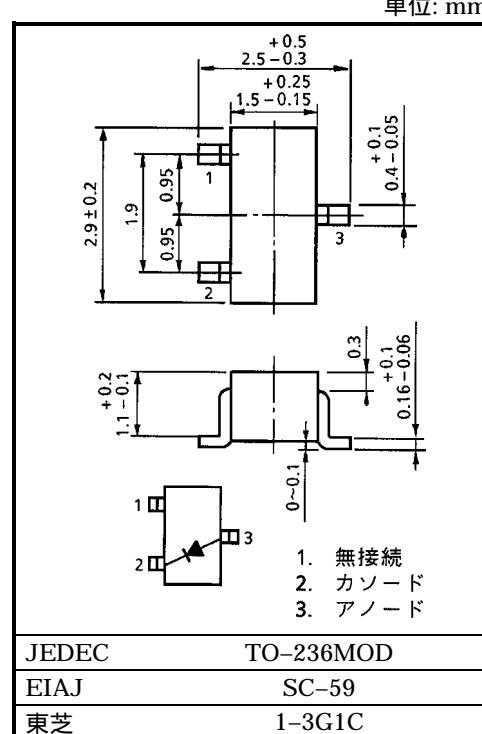


東芝ダイオード シリコンエピタキシャルプレーナ形

1SS190

超高速度スイッチング用

- 外形が小さい。 : SC-59
- 順方向特性が良い。 : VF (3) = 0.92V (標準)
- 逆回復時間が短い。 : t_{rr} = 1.6ns (標準)
- 端子間容量が小さい。 : C_T = 2.2pF (標準)



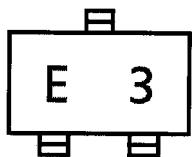
最大定格 (Ta = 25°C)

項目	記号	定格	単位
せん頭逆電圧	V _{RM}	85	V
逆電圧	V _R	80	V
せん頭順電流	I _{FM}	300	mA
平均整流電流	I _O	100	mA
サージ電流 (10ms)	I _{FSM}	2	A
許容損失	P	150	mW
接合温度	T _j	125	°C
保存温度	T _{stg}	-55 ~ 125	°C

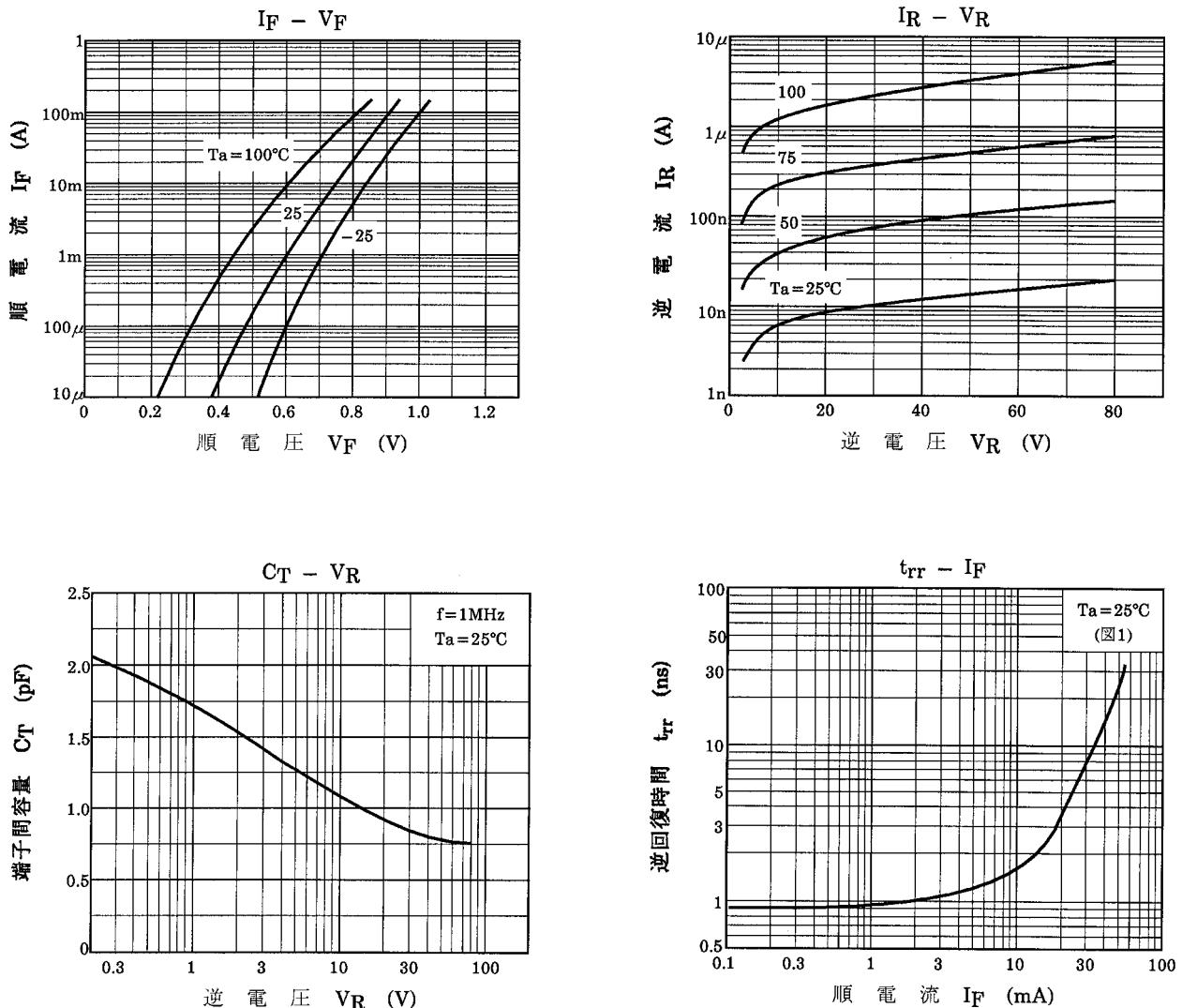
960917TAA1

- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、一般に半導体製品は誤作動したり故障することがあります。当社半導体製品をご使用頂く場合は、半導体製品の誤作動や故障により、他人の生命・身体・財産が侵害されることのないように、購入者側の責任において、装置の安全設計を行うことをお願いします。
- なお、設計に際しては、最新の製品仕様をご確認の上、製品保証範囲内でご使用頂くとともに、考慮されるべき注意事項や条件について「東芝半導体製品の取り扱い上の注意とお願い」、「半導体信頼性ハンドブック」などをご活用ください。
- 本資料に掲載されている技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社および第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行つものではありません。
- 本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。

現品表示

電気的特性 ($T_a = 25^\circ\text{C}$, $V_{CC} = 12$, $V_S = 12\text{V}$)

項目	記号	測定条件	最小	標準	最大	単位
順 電 壓	$V_F(1)$	$I_F = 1\text{mA}$		0.61		V
	$V_F(2)$	$I_F = 10\text{mA}$		0.74		
	$V_F(3)$	$I_F = 100\text{mA}$		0.92	1.20	
逆 電 流	$I_R(1)$	$V_R = 30\text{V}$			0.1	μA
	$I_R(2)$	$V_R = 80\text{V}$			0.5	
端 子 間 容 量	C_T	$V_R = 0, f = 1\text{MHz}$		2.2	4.0	pF
逆 回 復 時 間	t_{rr}	$I_F = 10\text{mA}$ (図 1)		1.6	4.0	ns

図1. 逆回復時間 (t_{rr}) 測定回路